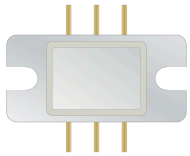
3400–4800 MHz GaN Amplificateur de puissance encapsulé — PSAT 43 dBm (typique)

LCI-PA-3400-4800-PS43T · 3400–4800 MHz · GaN Amplificateur de puissance encapsulé.



Valeurs du tableau RF: PSAT 43 dBm (typique); Gain en puissance 23 dB (typique); PAE 45 % (typique). Conditions de mesure RF: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW.

CMW010B

Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensions du boîtier: 18.03 × 8.7 mm.

Caractéristiques RF

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	3400	-	4800	MHz
Puissance de sortie saturée	-	42	43	-	dBm
Gain de puissance	-	22	23	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	-	35	45	-	%
Planéité du gain en puissance	-	-	-	±1	dB

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain	-	-	-	-	28	V
Tension de grille	-	-	-	-	-2.8	V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	-	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	-	-5	-	-	V
Température de stockage	-	-65	-	150	°C
Puissance d’entrée maximale	-	-	-	24	dBm

Dimensions du boîtier

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions du boîtier	18.03 × 8.7	mm
Envergure des broches	14.7	mm

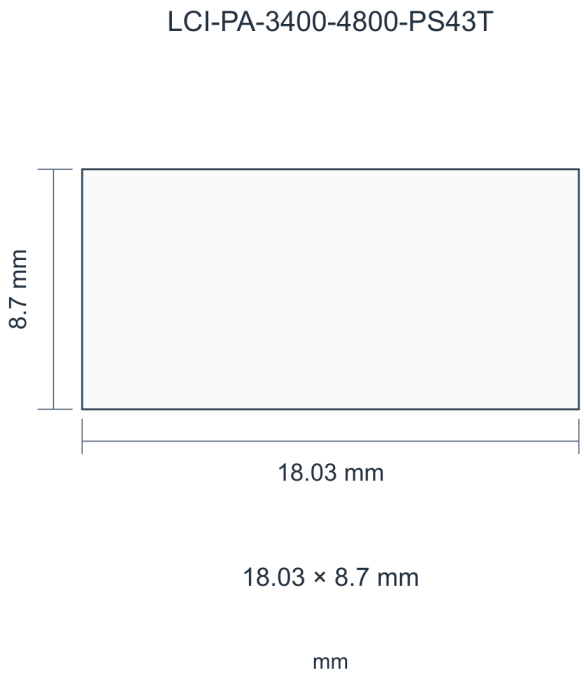
Publication actuelle · 1.6 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.5.

Notes d’intégration

CMW010B Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Plan d’encombrement mécanique

Plan partiel des dimensions confirmées en mm. Pour le montage, reportez-vous au plan d’installation complet.

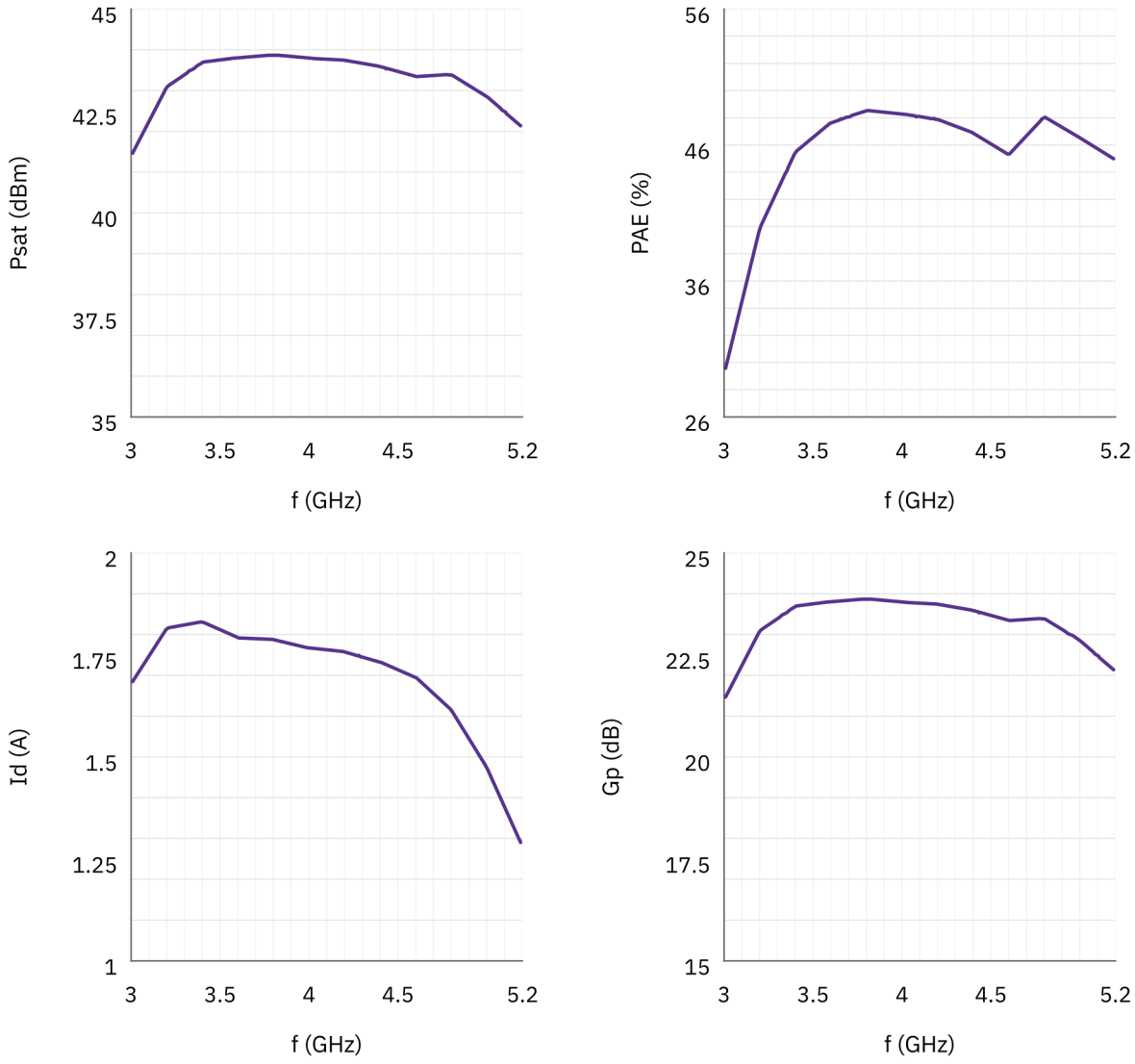


Courbes de performance

Chaque courbe de performances correspond aux conditions de fonctionnement indiquées sur la figure.

Onde continue (CW) — Puissance de sortie saturée; Rendement en puissance ajoutée; Courant dynamique de drain; Gain de puissance; IMD3.

Notes de la figure : Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=20dBm. Les valeurs lues sont approximatives. IMD3: Pout = 38 dBm; Vg = −3 V.



IMD3 | Pout = 38 dBm · Vg = −3 V

f (GHz)	IMD3 L (dBc)	IMD3 R (dBc)
3.7	−29.56	−29.87
4.1	−29.4	−29.8
4.5	−28.8	−29.2

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.